

بسم الله الرحمن الرحيم

١٣٢٥



دانشکده فنی

گروه مهندسی برق

ساختارهای متامتریال و کاربرد آن در بهبود عملکرد آنتن‌ها

رضا موحدی نیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مخابرات-گرایش میدان

استاد راهنمای:

دکتر محمد نقی آذرمنش

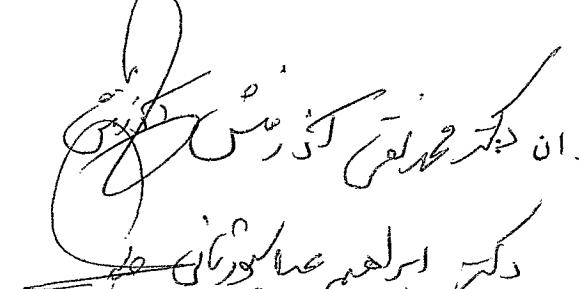
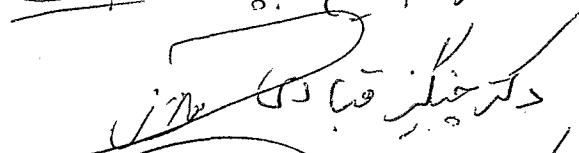
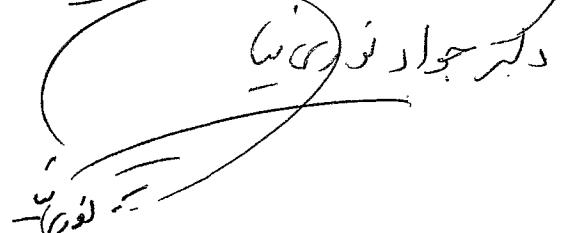
شهریور ماه ۱۳۸۸

۱۳۸۹/۰۹/۰۸
حق چاپ و انتشار برای دانشگاه ارومیه محفوظ است.

نشریه امدادات مددک ساز
تسبیح

۱۳۸۶۲۵

پایان نامه خالق / آقای رضا بوجیگی بنا .. به تاریخ ۱۱/۶/۲۱
سازه مورد پذیرش هیات محترم داوران بارتبه عالی
و نمره قرار گرفت.
۱۹/۵ لرده و سعی


دکتر ابراهیم علی‌اصغر جواهری

دکتر غلامرضا قبادت

دکتر جواد نوری

- ۱ - استاد راهنمای و رئیس هیئت داوران دکتر محمدعلی کردشیان :
- ۲ - داور خارجی :
- ۳ - داور داخلی :
- ۴ - ناینده تحصیلات تكميلی :

حق چاپ و نشر برای دانشگاه ارومیه محفوظ می باشد.

تقدیم

خانواده میربانم

تقدیر و تشکر

سپاس ایزدمنان را که توفیق به پایان رسیدن این پژوهش را عطا فرمود. در انجام این پژوهش افراد زیادی سهیم بودند، که بر خود لازم می‌دانم، از ایشان تشکر و قدردانی نمایم.

نخست از استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد نقی آذرمنش که در انجام این پژوهش و در طول دو دوره تحصیل، مرا با صیر و درایت خویش راهنمایی نمودند، تشکر و قدردانی می‌نمایم.

از آقای مهندس جواد محمد بیگی، که در امور نرم‌افزار بسیار کمک نمودند، و آقای مهندس فرهاد خسروی، بخاطر کمک‌های بی‌دریغشان در تکمیل این مجموعه کمال تشکر را دارم. از تمامی اساتید محترم گروه مهندسی برق، دانشگاه ارومیه، آقایان؛ دکتر قبادی، دکتر نوری نیا و دیگر اساتید و کارشناسان گروه بخاطر زحمات جبران ناپذیرشان در طول دوره تحصیلی خود در گروه، بسیار سپاسگزارم.

از همکلاسی‌ها و دوستان بسیار خوبم، آقایان؛ مهندس محمد اجارودی، مهندس عقیل درخشان، و خانم‌ها؛ مهندس مدنی که در سختی‌های انجام این تحقیق سهیم بودند، کمال تشکر را دارم. در پایان از محبت‌های بی‌پایان خانواده عزیزم، که مشوق همیشگی من در طول زندگی هستند، کمال تشکر را دارم.

سلامتی و سربلندی تک تک این عزیزان را از خداوند مهریان خواستارم.

چکیده

ساختارهای متامتریال^۱ با توجه به ویژگی‌های منحصر بفرد خود، توانسته است خود را به عنوان یکی از مهمترین موضوعات طراحی مایکروویوی مطرح نماید. کاربرد این ساختارها در طراحی موجبرها، فیلترها، کوپلرها و بخصوص در مبحث آتن‌ها به سرعت در حال گسترش می‌باشد، ولی تعداد کمی از کاربرد این ساختارها در بهبود عملکرد آتن‌های تک قطبی مسطح^۲ تا به امروز گزارش شده است. این نوع از آتن‌ها دارای ویژگی‌های لازم برای تکنولوژی حال حاضر بوده و بهترین گزینه برای نسل آینده به حساب می‌آیند. در این پایان نامه این نوع از آتن‌ها برای بررسی‌های بیشتر و ارائه روش‌ها و فرضیات جدید انتخاب شده است. در این پایان نامه سه هدف اصلی وجود دارد:

- ۱- طراحی و شبیه سازی آتن تک قطبی مسطح در پهنه‌ای باند بسیار وسیع.
- ۲- بدست آوردن نفوذپذیری منفی با استفاده از ساختارهای دوگان تشدید کننده الکتریکی سلفی - خازنی (CELC).
- ۳- جای گذاری CELC در پیج تشبعی آتن تک قطبی مسطح و ایجاد عملکرد فیلترینگی متغیر و اعتبار پخشیدن این فرضیه از طریق نتایج شبیه سازی و ساخت.

در ابتدا آتن تک قطبی مسطح پایه با پیج تشبعی دایروی شبیه سازی شده است. با بهره گیری از کترل فاصله پیج تشبعی آتن تا صفحه زمین و تغییر در صفحه زمین، توانستیم بصورت همزمان پهنه‌ای باند و تطبیق امپدانسی را کترول نماییم که نتیجه آن افزایش چشمگیر پهنه‌ای باند و امکان پوشش سیستم^۳ UWB (از $3/1$ تا $10/6$ گیگا هرتز) و همچنین بهبود محسوس پارامتر^۴ VSWR (که معیار تطبیق امپدانسی است) بوده است.

به منظور ایجاد عملکرد فیلترینگی متغیر در آتن تک قطبی مسطح، از میان ساختارهای متعدد متامتریال، ساختارهای CELC انتخاب گردید. دلیل این انتخاب، به علت ویژگی‌های منحصر بفرد این مواد جدید همچون ابعاد بسیار کوچکتر از طول موج و آسان بودن استفاده از آنها در صفحات مسطح می‌باشد. ساختارهای CELC با قرار گرفتن در ماده میزان، پارامترهای موثر ماده را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و باعث ایجاد نفوذپذیری منفی در بازه‌هایی از فرکانس می‌گردند. در این پایان نامه با استفاده از تحلیل تمام موج این پارامترهای موثر بدست آمده شده است.

در نهایت از میان ساختارهای پیشنهادی CELC، آتن تک قطبی بسیار باند جدید با عملکرد فیلترینگی متغیر طراحی و ارائه شده است. عملکرد فیلترینگی برای اولین بار با استفاده از ساختارهای CELC بوجود آمده و نشان داده شده است که

¹ Metamaterial

² Printed (planar) Monopole Antenna

³ Ultra-Wideband (UWB)

⁴ Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)

ساختارهای CELC تا زمانی که دارای ضریب کیفیت بالا و ابعاد کوچک همانند ساختارهای CSRR می‌باشند، می‌توانند به طور موثرتری در تولید باند ممتوغه در آنتن‌های تک قطبی به کار روند. علاوه بر این برخلاف ساختارهای CSRR پهنه‌ای باند فیلتر در این حالت در محدوده $8/0$ تا چندین گیگا هرتز در هر فرکانس فیلتر شده‌ای قابل تنظیم می‌باشد.

فهرست

۱.....	مقدمه
۵.....	فصل اول مروری بر ساختارهای متامتریال و خواص آنها
۵.....	۱-۱ مقدمه
۶.....	۲-۱ توصیف ساختارهای متامتریال
۸.....	۳-۱ انواع ساختارهای متامتریال
۸.....	۱-۳-۱ ساختار متامتریال با سیمهای فلزی
۹.....	۲-۳-۱ ساختار رزوناتور رینگ شکافدار
۱۱.....	۳-۳-۱ ساختار ماده مركب DNG
۱۲.....	۴-۱ پارامترهای موج در مواد DNG
۱۳.....	۵-۱ برخورد عمود موج به یک دیواره DNG
۱۴.....	۶-۱ امواج پسرو
۱۶.....	۷-۱ شکست منفی
۱۸.....	۸-۱ متامترالها با ضریب شکست نزدیک به صفر
۱۹.....	نتیجه گیری
۲۰.....	فصل دوم کاربرد ساختارهای متامتریال در بهبود عملکرد آتنها
۲۰.....	۱-۲ مقدمه
۲۰.....	۲-۲ کاربرد ساختارهای متامتریال DNG و SNG در آتنها
۲۱.....	۱-۲-۲ پوششی از متامتریال برای بهبود عملکرد آتن
۲۳.....	۳-۲ تحقق ساختارهای متامتریال به عنوان رساناهای مصنوعی مغناطیسی به منظور کاربرد در آتن
۲۶.....	۴-۲ متامتریال با ضریب شکست صفر برای افزایش سمتگرایی

۵-۲	استفاده از ماتریال بعنوان زیر لایه در آتنن پچ	۲۷
۶-۲	کاهش تلفات برگشتی و افزایش پهنهای باند در آنتهای مسطح	۲۸
۷-۲	ساختارهای دو بعدی مسطح با ضریب شکست صفر و کاربردهای آن در آنتنها	۳۰
۷-۲	خطوط انتقال MTM	۳۰
۲-۷-۲	استفاده از خطوط انتقال MTM در آرایههای آتنن با تغذیه سری	۳۳
۳-۷-۲	آنتهای رینگی با ابعاد کوچک	۳۴
۸-۲	تشدید کنندهای ماتریال	۳۶
۱-۸-۲	روزانس مثبت، منفی و صفر در تشید کنندهای CRLH	۳۶
۲-۸-۲	آنتهای مرتبه صفر	۳۶
۳-۸-۲	آنتهای دو باندی رینگی	۳۷
۹-۲	تولید باند ممنوعه در آنتهای پهن باند	۳۷
	نتیجه گیری	۳۹
فصل سوم طراحی و شبیه سازی آتنن تک قطبی مسطح با عملکرد فیلترینگی متغیر بر اساس ساختارهای دوگان تشید کنندهای سلفی - خازنی		
۴۰		
۱-۳	مقدمه‌ای بر سیستمهای UWB	۴۰
۱-۱-۳	مفهوم سیستمهای UWB	۴۰
۲-۱-۳	مزایای سیستمهای UWB	۴۱
۲-۱-۳	توانایی به اشتراک گذاشتن طیف فرکانسی	۴۲
۲-۱-۳	ظرفیت کanal بالا	۴۲
۳-۱-۳	توانایی کار با نسبت سیگنال به نویز پایین	۴۲
۴-۱-۳	کاهش احتمال ردیابی و حائل شدن	۴۳
۵-۱-۳	پایداری در برابر پدیده گیرافتادگی	۴۳

۶-۲-۱-۳	عملکرد بالا در کانالهای چند مسیره.....	۴۳
۷-۲-۱-۳	خصوصیت نفوذپذیری بالا.....	۴۳
۸-۲-۱-۳	ساده بودن سبک معماری فرستنده-گیرنده.....	۴۴
۲-۳	کاربردهای سیستم UWB.....	۴۵
۳-۳	آنتن پچ میکرواستریپ	۴۵
۴-۳	آننهای تک قطبی مسطح	۴۸
۱-۴-۳	أنواع مختلف آنتهای تک قطبی مسطح	۴۸
۲-۴-۳	روشهای تغذیه.....	۴۹
۱-۲-۴-۳	CPW.....	۴۹
۲-۲-۴-۳	خطوط میکرواستریپ	۵۰
۱-۲-۴-۳	ثابت دی الکتریک موثر خط تغذیه میکرواستریپ.....	۵۱
۲-۲-۴-۳	امپدانس مشخصه خط تغذیه میکرواستریپ	۵۲
۳-۴-۳	روشهای افزایش پهنای باند.....	۵۲
۴-۴-۳	تولید باند ممنوعه در آنهای تک قطبی	۵۵
۵-۳	روش طراحی آنتن تک قطبی دایروی مورد نظر با پهنای باند بسیار وسیع	۶۲
۱-۵-۳	طراحی آنتن تک قطبی مسطح دایروی	۶۳
۲-۵-۳	طراحی آنتن تک قطبی مسطح دایروی در باند بسیار وسیع	۶۴
۳-۳	طراحی و بکارگیری ساختار ماتماتریال ELC در تولید باند ممنوعه در آنتن تک قطبی پهن باند	۶۵
۱-۶-۳	مقدمهای بر ساختارهای ELC	۶۵
۲-۶-۳	ساختارهای دوگان تشدید کنندهای ELC	۶۸
۳-۶-۳	مدل نمودن CELC در نرم افزار HFSS و بدست آوردن پارامترهای موثر آن	۶۸
۱-۳-۶-۳	روشهای موجود برای بدست آوردن پارامترهای موثر ساختارهای ماتماتریال	۶۸
۲-۳-۶-۳	شبیه سازی CELC در HFSS و بدست آوردن پارامترهای موثر آن	۷۲

۷۴.....	۴-۶-۳ بکارگیری CELC در آنتن‌های تک قطبی برای تولید باند ممنوعه
۷۵.....	۷-۳ مطالعه پارامتری و نتایج اندازه‌گیری
۸۱.....	۸-۳ نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
۸۲.....	مراجع

فهرست اشکال

صفحه	عنوان
	فصل اول
۵	شکل ۱-۱ نمونه‌ای از ساختارهای ماتامتریال که از تزریق به ماده میزبان بوجود می‌آید
۷	شکل ۲-۱ طبقه بندی مواد بر اساس پارامترهای ساختاری
۹	شکل ۳-۱ نمایی از سیم‌های فلزی به هم پیوسته
۱۰	شکل ۴-۱ نمایی از ساختار استوانه‌ای SRR
۱۲	شکل ۵-۱ اولین ساختار DNG که توسط اسمیت و همکارانش ارائه گردید. در این ساختار از SRR و TW بطور همزمان استفاده شده است. الف) در یک بعد ب) در دو بعد
۱۲	شکل ۶-۱ آرایش ماده مرکب همسانگرد الف) یک بعدی ب) دو بعدی ج) سه بعدی
۱۴	شکل ۷-۱ نمایی شماتیک از برخورد عمود موج به دیوارهای از ماتامتریال
۱۶	شکل ۸-۱ جریان سطحی ایجاد شده در میان دو سطح (پیکان مشکی و آبی) برای ترتیب نشان دهنده بردار موج و بردار پوئیتینگ (می باشدند)
۱۷	شکل ۹-۱ نمایی از برخورد مایل موج بر سطح مشترک DPS-DNG
۱۸	شکل ۱۰-۱ شکست موج منفی شبیه سازی شده با روش FDTD (ارائه شده در مرجع [۳۲]).
۱۸	شکل ۱۱-۱ خط ضریب شکست منفی در تقاطع انواع مختلف مواد
	فصل دوم
۲۲	شکل ۱-۲ یک پوشش DNG که با ترکیب با آتنن دو قطبی تولید رزونانس می‌نماید
۲۲	شکل ۲-۲ بهره توان تشعشعی آتنن دو قطبی قرار گرفته شده در پوشش‌های مختلف DNG
۲۴	شکل ۳-۲ بلوک ماتامتریال تشکیل شده از دو CLL که با برخورد موج از سمت شکافهای خازنی، همانند AMC عمل نموده و یا تابش در جهت مخالف همانند AEC عمل می‌نماید.
۲۴	شکل ۴-۲ الف) نمایی از آتنن دو قطبی و ساختار AMC ب) شبیه سازی HFSS برای بدست آوردن رزونانس میان آتنن و ساختار AEC (ارائه شده در مرجع [۳۷])
۲۵	شکل ۵-۲ الگوی تشعشعی میدان دور یاری آتنن دو قطبی و ساختار AMC الف) صفحه E ب) صفحه H (مرجع [۳۷])
۲۵	شکل ۶-۲ میدان الکتریکی تزدیک شبیه ساری شده توسط HFSS الف) صفحه E ب) صفحه H (مرجع [۳۷])

- ۲۶ شکل ۷-۲ نمایی از خروج امواج متعامد از دیوارهای با ضربیت شکست صفر
- ۲۷ شکل ۸-۲ توزیع شدت میدان الکتریکی پیش بینی شده توسط FDTD در زمانهای گوناگون (الف) $t = 167\Delta t$ (ب) $t = 4833\Delta t$ (پ) $t = 1000\Delta t$
- ۲۸ شکل ۹-۲ تلفات برگشتی آنتن پیچ با سه زیرلایه متفاوت.
- ۲۹ شکل ۱۰-۲ (الف) آنتن پیچ متداول (ب) آنتن پیچ بارگذاری شده با SRR
- ۳۰ شکل ۱۱-۲ مقایسه تلفات برگشتی آنتن پیچ بارگذاری شده با لایه‌های مختلف (ارائه شده در مرجع [۳۴])
- ۳۱ شکل ۱۲-۲: سلوولی وحد ارخط انتقال بارگذاری شده با المان‌های راکتیو
- ۳۲ شکل ۱۳-۲ نمودار پراکندگی یک سلوول واحد MTM
- ۳۳ شکل ۱۴-۲ نمایش انتشار خارج از مخروط تشعشع با استفاده از نمودار پراکندگی MTM
- ۳۴ شکل ۱۵-۲ نمایی از ساختار خط انتقال دهنده فاز MTM
- ۳۵ شکل ۱۶-۲ (الف) آرایه آنتن با تغذیه خطوط متداول (ب) آرایه آنتن با تغذیه خطوط MTM
- ۳۶ شکل ۱۷-۲ عملکرد پویایی زاویه آرایه آنتن بر اساس تغذیه‌های متفاوت (ارائه شده در مرجع [۱۷])
- ۳۷ شکل ۱۸-۲ نمونه‌ای از آنتن رینگی در فرکانس $1/5$ گیگا هرتز
- ۳۸ شکل ۱۹-۲ الگوی تشعشعی اندازه گیری شده و شبیه سازی شده آنتن رینگی (الف) صفحه E (ب) صفحه H (ارائه شده در مرجع [۴۶])
- ۳۹ شکل ۲۰-۲ آنتن مرتبه صفر، تشکیل شده از ۴ سلوول واحد تحریک شده در فرکانس $7/61$ گیگا هرتز (الف) نمودار تلفات برگشتی به همراه شکل آنتن (ب) مقایسه نتایج اندازه گیری و شبیه سازی و حتی نتایج یک آنتن ۳۰ سلووله (ارائه شده در مرجع [۴۶])
- ۴۰ شکل ۲۱-۲ آنتن دو باندی رینگی شکل (الف) نمودار تلفات برگشتی به همراه شکل آنتن (ب) الگوی تشعشعی در دو فرکانس متفاوت
- ۴۱ شکل ۲۲-۲ آنتن ارائه شده در مرجع [۴۹] (ب) مقایسه پارامتر VSWR شبیه سازی شده و اندازه گیری شده
- ۴۲ شکل ۲۳-۲ آنتن اسلات ارائه شده در مرجع [۵۱] (ب) مقایسه پارامتر VSWR شبیه سازی شده و اندازه گیری شده
- ### فصل سوم
- ۴۳ شکل ۱-۳ یک سیگنال باند باریک در (الف) حوزه زمان (ب) حوزه فرکانس
- ۴۴ شکل ۲-۳ یک پالس UWB در (الف) حوزه زمان (ب) حوزه فرکانس. (پهنهای باند و شدت طیف توان را با شکل ۱-۳ مقایسه نمایید).
- ۴۵ شکل ۳-۳ همزیستی سیگنال‌های UWB با پهنهای باند باریک و سیگنال‌های پهن باند در طیف RF
- ۴۶ شکل ۴-۳ (الف) پدیده چند مسیره در لینک‌های مخابراتی (ب) تاثیر پدیده چند مسیره بر سیگنال‌های باند باریک (ج) تاثیر پدیده چند مسیره بر سیگنال‌های بسیار پهن باند
- ۴۷ شکل ۵-۳ (الف) ساختار متداول یک فرستنده - گیرنده باند باریک (ب) ساختار یک فرستنده - گیرنده پهن باند
- ۴۸ شکل ۶-۳ ساختار آنتن مسطح میکرواستریپی

- شکل ۷-۳ ساختار آنتن تک قطبی چاپی میکرواستریپی با پارامترهای تعریف کننده آن
شکل ۸-۳ نمایی از اشکال متفاوت آنتن‌های تک قطبی
شکل ۹-۳ نمایی از خط تغذیه CPW
شکل ۱۰-۳ نمونه‌ای از آنتن تک قطبی مسطح با تغذیه CPW ارائه شده در مرجع [۵۹]
شکل ۱۱-۳ نمایی از خط میکرواستریپ
شکل ۱۲-۳ نمونه‌ای از آنتن تک قطبی مسطح با تغذیه میکرواستریپ ارائه شده در مرجع [۶۰]
شکل ۱۳-۳ آنتن تک قطبی چاپی با پهنهای باند افزایش یافته با استفاده از شکاف‌های توسعه یافته در لبه‌های کناری پچ
تشعشعی، صفحه زمین تغییر شکل باشد و دو شکاف باریک در محل اتصال خط تغذیه به پچ تشعشعی [۶].
شکل ۱۴-۳ (الف) نمایی از ۴ آنتن متفاوت که با خطوط مختلف به نمایش در آمد است (ب) نمودار VSWR ۴ آنتن
مورد نظر (مرجع [۳۴])
شکل ۱۵-۳ (الف) جریان سطحی شبیه سازی شده در فرکانس ۷ گیگا هرتز (ب) تغییرات پارامتر VSWR بر حسب S_h
(مرجع [۳۴])
شکل ۱۶-۳ مثالهایی از روش‌های دیگر افزایش پهنهای باند در آنتن‌های تک قطبی مسطح ارائه شده در (الف) مرجع [۴]
(ب) مرجع [۳۵] (ج) مرجع [۳۴]
شکل ۱۷-۳ آنتن‌های تک قطبی با قابلیت فیلترینگی تک بانده ارائه در (الف) مرجع [۶۸] و (ب) مرجع [۶]
شکل ۱۸-۳ نمودار VSWR برای طول‌های مختلف از بازوی شکاف U-شکل در آنتن تک قطبی فیلتر شده، ارائه
شده در [۲۱].
شکل ۱۹-۳ توزیع جریان سطحی در فرکانس فیلترینگ (مرجع [۶])
شکل ۲۰-۳ آنتن ارائه شده در مرجع [۶۲] (الف) نمای روی رو (ب) نمای پشت
شکل ۲۱-۳: توزیع جریان سطحی در فرکانس (الف) ۳ گیگا هرتز (ب) ۵/۵ گیگا هرتز (ج) ۷ گیگا هرتز (د) ۱۰ گیگا هرتز
(ارائه شده در مرجع [۶۲])
شکل ۲۲-۳ آنتن‌های تک قطبی چاپی با عملکرد فیلترینگی تک بانده ارائه شده در (الف) مرجع [۱۹] و (ب) مرجع [۶۳].
شکل ۲۳-۳ (الف) نمودار VSWR برای طول‌های مختلف از بازوی متصل به پچ تشعشعی در آنتن مرجع [۱۹]، (ب)
نمودار توزیع جریان سطحی روی بدنه همان آنتن در فرکانس فیلتر (۵/۵ گیگا هرتز).
شکل ۲۴-۳ (الف) اولین تحقق استفاده از CSRR در آنتن تک قطبی (ب) نمودار تلفات برگشتی آنتن (ارائه شده در
مرجع [۵۰])
شکل ۲۵-۳ آنتن تک قطبی دایروی با دو بانده فیلتر شده [۷۵] (الف) ساختار آنتن، (ب) ساختار شکاف‌های C-شکل
تو در تو قرار گرفته در داخل پچ دایروی.
شکل ۲۶-۳ نمودار VSWR برای آنتن تک قطبی دایروی با دو باند فیلتر شده [۷۵]
شکل ۲۷-۳ نمایی از ساختمان اولیه آنتن مورد نظر

- شکل ۳-۲۸ تغییرات پارامتر VSWR بر حسب فاصله h ۶۴
- شکل ۲۹-۳ مقایسه تغییرات پارامتر VSWR بر اساس دو ساختار متفاوت صفحه زمین ۶۵
- شکل ۳۰-۳ نمایی از یک سلوول واحد Swiss Roll ۶۶
- شکل ۳۱-۳ (الف) نمایی از ساختار ELC ساخته شده ب) مدار معادل ۶۷
- شکل ۳۲-۳ ساختارهای ELC (نشان داده شده با OE1-OE6) به همراه ساختارهای دوگان خود (نشان داده شده با CE1-CE6) ۶۹
- شکل ۳۳-۳ مقایسه نتایج شبیه سازی انجام شده (الف) مقاله [۶۹] ب) شبیه سازی انجام شده در پایان نامه ۷۲
- شکل ۳۴-۳ (الف) نمونه ای از CELC قرار گرفته در موجبر برای بدست آوردن پارامترهای موثر ب) نتایج شبیه سازی شده تلفات برگشتی ۷۳
- شکل ۳۵-۳ پارامتر موثر بدست آمده از نتایج شبیه سازی ۷۴
- شکل ۳۶-۳ سه نمونه انتخاب شده از CELC برای ایجاد عملکرد فیلترینگی متغیر در آنتهای تک قطبی مسطح (متامتریال مسطح ۰۱-O3) و دوگان آنها (C1-C3) (قسمتهای فلزی با رنگ خاکستری و شکافها با رنگ سفید مشخص شده‌اند). ۷۴
- شکل ۳۷-۳ نمایی از سه آتنن پیشنهاد شده (الف) نوع ۱ ب) نوع ۲ ب) نوع ۳ ۷۵
- شکل ۳۸-۳ نمودار VSWR شبیه سازی شده آنتهای پیشنهادی ۷۵
- شکل ۳۹-۳ نمودار VSWR شبیه سازی شده آتنن با مقادیر مختلف LS ۷۶
- شکل ۴۰-۳ نمودار VSWR شبیه سازی شده آتنن با مقادیر مختلف Ws ۷۷
- شکل ۴۱-۳ توزیع جریان در سه فرکانس متفاوت (الف) ۲/۱ (۵/۴ گیگا هرتز ب) ۵/۴ گیگا هرتز (۹ گیگا هرتز) ۷۷
- شکل ۴۲-۳ نمایی از آتنن ساخته شده ۷۸
- شکل ۴۳-۳ نمودار VSWR اندازه گیری شده آتنن، با شکاف CELC و نیز بدون آن. ۷۹
- شکل ۴۴-۳ بهره اندازه گیری شده آتنن با شکاف CELC و نیز بدون آن. ۷۹
- شکل ۴۵-۳ الگوی تشعشعی اندازه گیری شده در صفحات E و H (الف) فرکانس ۳.۵ گیگاهرتز ب) فرکانس ۹ گیگاهرتز. ۸۰

مقدمه

ساختارهای متامتریال برای اولین بار در سال ۱۹۶۷ توسط ویکتور وسلاگو^۱ به صورت تئوری ارائه شد [۱]. پس از سه دهه پندری^۲ و همکارانش ساختارهای متناوب از سیمهای فلزی را معرفی کردند که گذردهی منفی را در باندهای فرکانسی معینی نشان می‌داد [۲]. در سال ۱۹۹۹، پندری مطالعاتش را ادامه داد و آرایه‌ای متناوب از ساختارهای مصنوعی به نام تشدید کننده‌های رینگ شکافدار (SRR)، پیشنهاد نمود [۳]. پس از مدت کوتاهی از انتشار [۲] و [۳]، شلبی^۴ و همکارانش بر اساس مقاله‌ی پندری، ساختارهایی متناوب با رینگ شکافدار و سیمهای فلزی را طراحی کردند که دارای گذردهی و نفوذپذیری همزمان منفی بود [۴] که باعث جذابیت شدید خصوصیات و روش‌های تحقق عملی این مواد شد. کاربردهایی نظیر کوپلرهای پسرو [عوه]^۵، جبران فاز در تشدید کننده‌های کوچک الکتریکی [۷]، موجبرهای کوچکتر از طول موج با ابعاد افقی قرار گرفته در محدوده پایین انکسار [۱۲]-[۸]، افروختن تمرکر گرایی [۱۴ و ۱۳]، تابش کرنو^۶ [۱۵]، اثر داپلر، تونل فوتونی و آتن‌های موج پیشرو [۱۶] و دیگر کاربردها، تنها نمونه‌های کوچکی از وسعت کاربرد این مواد در طراحی مایکروویوی می‌باشند.

هرچند امروزه ساختارهای متامتریال بطور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند ولی توجه کمتری به استفاده از این مواد در آتن‌ها صورت گرفته است. یکی از دلایل کاهش استفاده این مواد در آتن‌ها، حجم بزرگ این نوع از ساختارها می‌باشد. در سالهای اخیر، محققان روش دیگری برای طراحی ساختارهای متامتریال ارائه نمودند که در آن بر اساس اصل بایینت از دوگان ساختارهای تشدید کننده‌ی رینگ شکافدار (CSRR) و یا دوگان تشدید کننده‌ی الکتریکی سلفی-خازنی (CELC) استفاده می‌شود [۱۷ و ۱۸]. ابعاد بسیار کوچکتر از طول موج این مواد و آسان بودن استفاده از آنها در خطوط میکرواستریپ از ویژگی‌های شاخص این ساختارهای جدید می‌باشد. با استفاده از این ساختارها می‌توان بر مشکل افزایش حجم ساختارهای متامتریال غلبه نمود و به راحتی از آن‌ها در طراحی مدارات گوناگون و بخصوص در بهبود عملکرد آتن‌ها استفاده نمود.

در ارتباطات مدرن امروز و بخصوص در دهه‌های اخیر، سیستم‌های مخابراتی باند بسیار وسیع یا UWB جهت انتقال پر سرعت ا-

نوع مختلف داده‌ها در فواصل نسبتاً کوتاه و با توان عملیاتی بالا، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۲ میلادی، مجمع ارتباطات فدرال وابسته به دولت آمریکا (FCC^۷) استفاده از این سیستم مخابراتی (UWB) را در چندین باند فرکانسی مختلف (۰-۲۹ GHz و ۹۶۰ MHz-۱۰/۶ GHz و ۲/۱-۱۰/۶ GHz) و با داشتن توان تشعشعی همه جهت مؤثر (EIRP^۸) تحقیق بخشید [۱۹] و [۲۰].

^۱ Veselago

^۲ Pendry

^۳ Shelby

^۴ Čerenekov radiation

^۵ Federal Communications Commission

^۶ Effective Isotropic Radiation Power (EIRP < -41.3 dBm/MHz)

بخش اصلی در این سیستم، آتنن باند پهن با ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر در این زمینه و شناسایی و بکارگیری انواع باندهای فرکانسی متنوع توسط مهندسین و سازندگان ابزارهای مخابراتی، نیاز به افزایش دامنه عملکردی این نوع خاص از آتنن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. آتنن‌های بکار گرفته شده در تکنولوژی UWB علاوه بر پهنانی باند امپدانسی بالا باید دارای مشخصات تشعشعی مناسب (از جمله پترن تشعشعی همه جهته، راندمان بالا و تغییرات کم برای بهره در کل باند)، ابعاد کوچک و ساختاری مسطح نیز باشند. از جمله کاربردهایی که اخیراً برای این نوع از آتنن‌ها معروفی شده است، می‌توان به مورد استفاده قرار گرفتن در مدارات^۱ RFID، شبکه‌های جستجوگر، رadar و همچنین شبکه‌های ارتباطی محلی همچون WLAN اشاره کرد [۲۱-۲۹].

انواع مختلفی از ساختارها برای بدست آوردن پهنانی باند امپدانسی بالا ارائه شده و تحقیقات گسترده‌ای برای پیشرفت عملکرد هر کدام انجام گرفته است. این تحقیقات به عمل آمده، آتنن‌های چاپی شکافدار^۲ و آتنن‌های مسطح تک یا دو قطبی را به عنوان بهترین گزینه برای استفاده در سیستم UWB معرفی می‌نمایند. دلیل اصلی انتخاب این نوع از آتنن‌ها وجود ویژگی‌هایی همچون ا- مکان تولید پهنانی باند خیلی بالا، پترن تشعشعی همه جهته در کل باند، امکان تطبیق امپدانسی آسان و بهره مناسب، در عملکرد فرکانسی آنها می‌باشد [۲۲-۲۹].

در این پایان نامه نیز آتنن تک قطبی مسطح برای تحقیقات بیشتر انتخاب شده است. این نوع آتنن‌ها جزء خانواده آتنن‌های تک قطبی، مانند یک رشته سیم نازک با ساختار عمودی نسبت به صفحه زمین و با تغذیه کابل کواکسیالی محسوب می‌شوند که برای بهبود کارایی و افزایش هرچه بیشتر دامنه عملکردی آنها، به حالت مسطح و با تغذیه میکرواستریپی تغییر شکل داده اند و تمامی اشکال استفاده شده در این نوع آتنن‌ها مانند مخروطی، کروی و یا دیسک‌های بیضوی، دایروی و چند ضلعی‌ها به عنوان بخش تشعشعی آتنن، این بار در حالت چاپ شده بر روی زیرلایه دوباره مورد استفاده و بررسی قرار گرفته‌اند. در ساختار آتنن تک قطبی چاپی از یک خط میکرواستریپ که از پشت زیرلایه توسط یک صفحه فلزی ناقص (زمین آتنن) مورد پوشش قرار گرفته است، برای تغذیه پیچ تشعشعی استفاده می‌شود. بخش تشعشعی این آتنن توسط صفحه زمین پوشش داده نمی‌شود و در نتیجه ثابت دی الکتریک موثر (ϵ_{eff}) و همچنین ضریب کیفیت سیستم در این حالت مقادیری متغیر و بسیار پایین خواهد داشت. این موارد از عوامل اصلی در ایجاد پهنانی باند بالا برای این ساختار به حساب می‌آید. با انجام تحقیقات بسیار وسیع در چند سال اخیر مشخص شده است که این نوع آتنن می‌تواند با وجود داشتن ابعاد کوچک، هزینه ساخت پایین و طراحی نسبتاً آسان دارای باند فرکانسی خیلی بالا (فراتر از مقدار لازم برای سیستم UWB) با مشخصات تشعشعی خیلی خوب (پترن همه جهته و بهره مناسب) در کل باند باشد. علاوه بر این به علت داشتن ساختاری کاملاً مسطح و نوع تغذیه آن بهترین گزینه برای قرار گرفتن روی برد در کنار دیگر مدولهای RF به حساب باید. همچنین نشان داده شده است که ایجاد عملکرد فیلترینگی بر روی این ساختارها بدون نیاز به

¹ Radio Frequency Identification

² Printed Slot antenna

افزایش ابعاد یا وزن محصول و یا ایجاد پیچیدگی‌های خاصی برای طراحی، با حفظ ویژگی‌های قبلی، براحتی در حالات تحقیقاتی و صنعتی قابل حصول است.

مبحث بعدی جلوگیری از ایجاد تداخل (و کاهش تلفات حاصل از آن) ما بین این تعداد وسیع از باندهای فرکانسی بکار گرفته شده می‌باشد. باند فرکانسی در محدوده ۲/۱ تا ۱۰/۶ گیگا هرتز مربوط به سیستم UWB دارای اشتراکات متعددی با سیستم‌های دیگر از جمله WLAN و HIPERLAN/2 (در محدوده ۵ تا ۶ گیگا هرتز) می‌باشد. بنابراین طراحی یک آتنن با ویژگی‌های مذکور برای داشتن کارایی مناسب در سیستم UWB و همچنین قابلیت چند کاره بودن آن و یا به عبارتی تشخشع در یک باند فرکانسی وسیع و همزمان با آن فیلتر کردن یک یا چندین محدوده فرکانسی خاصی برای از بین بردن تداخل احتمالی، لازم و مناسب بنظر می‌رسد. البته باید این را نیز در نظر داشت که در حالت کلی اضافه نمودن بخشی بر ساختار آتنن برای تحقق بخشیدن قابلیت فیلترینگی، سیستم را پیچیده‌تر می‌نماید [۲۲-۱۹].

در این پایان نامه و در تحقیقات انجام شده، سعی شده است تمامی نتایج، مشاهدات و مقایسه‌های آنها و همچنین فرضیات جدید، ذکر شده و به حالات مختلفی نمایش داده شود و علاوه بر این، موارد ضروری با دلیل و ارجاعات لازم به تحقیقات قبلی به تأیید برسد. در متن این پایان نامه سعی شده است تا حدالامکان از ذکر مطالب تکراری جلوگیری شود. در این پایان نامه، برای پوشش کامل کلیه تحقیقات انجام گرفته شده، ۱ نمونه آتنن بهینه سازی شده، ساخته و تست شد که نتایج اندازه گیری و شبیه سازی مشابههای بسیاری داشتند. نوع زیرلایه در این آتنن FR4 با ضخامت ۱ میلی‌متر بوده که از بابت هزینه بسیار پایین می‌باشد. این نوع زیرلایه دارای ضربه دی الکتریک در حدود ۴/۴ الی ۴/۶ و تانزانت تلفات ۰/۰۲ می‌باشد. در شبیه سازی های انجام شده در این پایان نامه، از نرم افزارهای HFSS^۱ (ver. 10) و Ansoft Designer که پرتوی از الگوریتم‌های Finite Element و Moment Method بهره می‌گیرند، استفاده شده است.

متن این پایان نامه از ۳ فصل تشکیل شده است. فصل اول شامل مروری بر ساختارهای ماتماتریال و ویژگی‌های منحصر بفرد آن می‌باشد. شناختهای این نوع از ساختارها در بهبود عملکرد آتنن‌ها در فصل دوم بررسی شده است. فصل ۳ به بررسی مراحل شبیه سازی و ساخت آتنن تک قطبی مسطح با استفاده از ساختارهای ماتماتریال می‌پردازد. این فصل شامل مروری اجمالی بر سیستم‌های UWB، روند پیشرفت آتنن‌های تک قطبی مسطح و روش‌های مختلف افزای پهنای باند و تولید عملکرد فیلترینگی متغیرنیز می‌باشد. در این فصل تمامی روش‌های جدید برای ایجاد عملکرد فیلترینگی متغیر ارائه شده توسط مؤلف معرفی شده و بطور دقیق مورد بررسی، ارزیابی و مقایسه‌های لازم قرار می‌گیرد. در همین بخش نتایج اندازه گیری‌ها بهمراه مقایسه آنها با نتایج شبیه سازی، مربوط به دو نمونه آتنن ارائه شده در این پایان نامه می‌باشد. در فصل آخر، نتیجه گیری کلی از این مطالعات ارائه شده و همچنین پیشنهادات مناسبی برای کارهای آینده در جهت پیشرفت هرچه بیشتر عملکرد فیلترینگی این نوع از

^۱ High Frequency Structure Simulator (HFSS-Ver. 10), Ansoft Corporation 2005

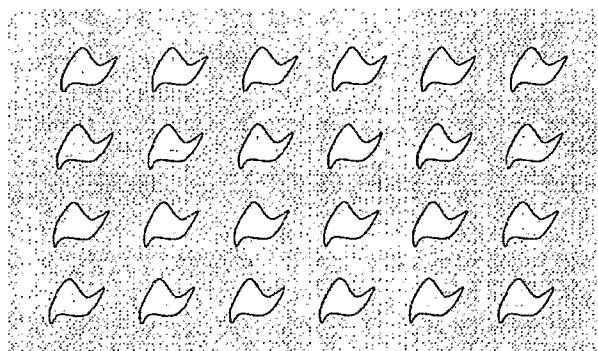
آتن‌ها معرفی خواهد شد. این پیشنهادات شامل روش‌های دیگری برای افزودن قابلیت چند کاره بودن برای این نوع آتن‌ها نیز
می‌باشد.

فصل اول

مروری بر ساختارهای متامتریال و خواص آنها

۱-۱ مقدمه

اولین تلاش علمی برای ساخت مواد مصنوعی توسط چاندر بس^۱ در اواخر قرن نوزدهم انجام گرفت. او توانست آزمایش تجربی را بر روی ساختار دوگانه‌ی مایکروویوی یا به اصطلاح امروزی اولین چیرال^۲ مصنوعی را ایجاد نماید [۲۳]. در سال ۱۹۱۴، لیندمان^۳ بر روی مواد مصنوعی کار کرد که از قرار دادن تکه‌های کوچک سیم در داخل ماده میزبان بدست می‌آمد [۲۴]. در سال ۱۹۴۸، کاک^۴ توانست با قرار دادن کره‌های هادی، دیسکها، و نوارهای هادی به صورت متناوب، ضریب شکست مؤثری ایجاد نماید که آنرا در ساخت لتر مایکروویوی بکار گیرد [۲۵]. از آن به بعد ساختارهای مرکب به عنوان موضوع اصلی تحقیقات در سراسر جهان مطرح شد. در سالهای اخیر تکنیکهای جدیدی برای بدست آوردن موادی مصنوعی که دارای رفتار مشابه با مواد موجود در طبیعت و یا حتی رفتاری که احراق آن در طبیعت امکان پذیر نباشد، به وجود آمده است. امروزه از این مواد مصنوعی به عنوان فراموادها و یا در اصطلاح متامتریال یاد می‌شود. متامتریالها از قرارگیری ساختارهایی با اشکال جدید در ماده میزبان بوجود می‌آیند (شکل ۱-۱). انواع مختلفی از مواد مرکب الکترومغناطیسی همانند متامتریالهای جفت-منفی، DPS، مواد چیرال، مواد امگا شکل، سیمهای، مواد جفت - همسانگرد، مواد خطی و غیر خطی، و مواد محلی و غیر محلی در سراسر جهان توسط گروه‌های تحقیقاتی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.



شکل ۱-۱: نمونه‌ای از ساختارهای متامتریال که از تزریق به ماده میزبان بوجود می‌آید.

¹ Chunder Bose

² Chiral

³ Lindman

⁴ Kock